

2SA1220,1220A/2SC2690,2690A

PNP/NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ

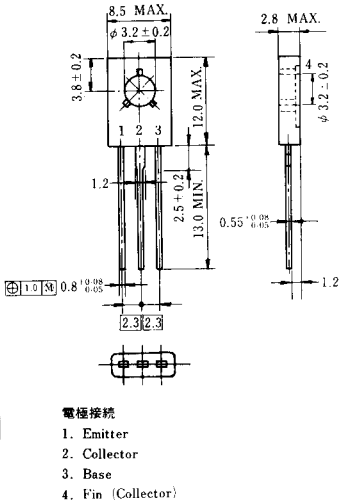
低周波電力増幅および高周波電力増幅用

PNP/NPN Silicon Epitaxial Transistor
 Audio, High Frequency Power Amplifier

- 実効出力50～100 W用パワーアンプのドライバ段として最適。
- TV垂直出力および音声出力に適する。
- 高耐圧であり、かつ f_T が高い。
- h_{FE} 、 f_T の大電流の伸びが良い。
- 小形薄形であるため、実装スペースが小さくできる。
- 放熱器への取付が容易にできる。

外形図／PACKAGE DIMENSIONS

(Unit : mm)



絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25 °C)

項 目	略 号	2SA1220/2SA1220A	2SC2690/2SC2690A	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	−120/−160	120/160	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	−120/−160	120/160	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	−5.0	5.0	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	−1.2	1.2	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	−2.5	2.5	A
ベース電流(直 流)	$I_{B(DC)}$	−0.3	0.3	A
全 損 失	$P_{T(Tc=25\text{ }^{\circ}\text{C})}$	20	20	W
全 損 失	$P_{T(Ta=25\text{ }^{\circ}\text{C})}$	1.2	1.2	W
ジャンクション温度	T_j	150	150	°C
保 存 温 度	T_{stg}	−55～+150	−55～+150	°C

* PW≤10 ms, Duty Cycle≤50 %

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)

2SA1220, 2SA1220A/2SC2690, 2SC2690A

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -120/120\text{ V}$, $I_E = 0$			−1.0/1.0	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -3.0/3.0\text{ V}$, $I_C = 0$			−1.0/1.0	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1}	$V_{CE} = -5.0/5.0\text{ V}$, $I_C = -5.0/5.0\text{ mA}$ *	35	150/105		
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2}	$V_{CE} = -5.0/5.0\text{ V}$, $I_C = -0.3/0.3\text{ A}$ *	60	140	320	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -1.0/1.0\text{ A}$, $I_B = -0.2/0.2\text{ A}$ *		−0.4/0.4	−0.7/0.7	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -1.0/1.0\text{ A}$, $I_B = -0.2/0.2\text{ A}$ *		−1.0/1.0	−1.3/1.3	V
利 得 帯 域 幅 積	f_T	$V_{CE} = -5.0/5.0\text{ V}$, $I_C = -0.2/0.2\text{ A}$		175/155		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10/10\text{ V}$, $I_E = 0$, $f = 1.0\text{ MHz}$		26/19		pF

* Pulse Test / PW≤350 μs , Duty Cycle≤2 %

h_{FE} 区分(h_{FE2}) / R : 60～120 Q : 100～200 P : 160～320